

## 研究評価委員会

「次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト」(事後評価)分科会

日時：平成23年 4月14日(木) 10:00～17:00

4月18日(月) 9:40～17:20

場所：全国町村議員会館(2階 第1～3会議室)

〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地

### 議事次第

<1日目 4月14日(木)> 10:00～17:00

#### 【公開セッション】

1. 開会、分科会の設置、資料の確認 10:00～10:10 (10分)
2. 分科会の公開について 10:10～10:15 (5分)
3. 評価の実施方法 10:15～10:20 (5分)
4. 評価報告書の構成について 10:20～10:25 (5分)
5. プロジェクトの概要説明 10:25～12:20 (説明70分、質疑45分)
  - 5.1 MIRAIプロジェクト第I～III期全体概要 10:25～10:45
  - 5.2 第III期の概要
    - (1) 事業の位置付け・必要性 } 10:45～11:00
    - (2) 研究開発マネジメント } 11:00～11:35
    - (3) 研究開発成果 } 11:00～11:35
    - (4) 実用化、事業化の見通し } 11:35～12:20

(昼食・休憩 60分)

【非公開セッション】 非公開資料取扱説明 13:20～13:25 (5分)

5.3 第I・II期成果の実用化・事業化の見通し 13:25～15:25 (120分)

実施企業8社 各15分(説明7分、質疑7分、入替1分)

(休憩 15分)

6. プロジェクトの詳細説明

6.1. 次世代半導体材料・プロセス基盤技術開発

① 新構造極限 CMOS トランジスタ関連技術開発

15:40～17:00 (説明40分、質疑40分)

< 2日目 4月18日(月) > 9:40~17:20

**【非公開セッション】**

6. プロジェクトの詳細説明

6.1. 次世代半導体材料・プロセス基盤技術開発

② 新探究配線技術開発 9:40~11:00 (説明 40分、質疑 40分)

③ 特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術開発  
11:00~12:20 (説明 40分、質疑 40分)

(昼食・休憩 50分)

6.2. 次世代半導体露光プロセス基盤技術開発

④ 次世代マスク基盤技術開発 13:10~14:30 (説明 40分、質疑 40分)

⑤ EUV 光源高信頼化技術開発 14:30~15:50 (説明 40分、質疑 40分)

(休憩 15分)

7. 全体を通しての質疑 16:05~16:45 (40分)

**【公開セッション】**

8. まとめ・講評 16:45~17:15 (30分)

9. 今後の予定、その他 17:15~17:20 (5分)

10. 閉会 17:20

以上